





Op	is teoretyczny materii skondensowanej
Przy	/bliżenie Borna Oppenheimera
	$H(\vec{r},\vec{R})\Psi(\vec{r},\vec{R}) = E\Psi(\vec{r},\vec{R})$
	$H_{el}(\vec{r},\vec{R})\Psi_{el}^{k}(\vec{r},\vec{R}) = \overline{\left[\hat{T}_{e} + V(\vec{r},\vec{R}) + V_{e}(\vec{r})\right]}\Psi_{el}^{k}(\vec{r},\vec{R}) = E_{el}^{k}(\vec{R})\Psi_{el}^{k}(\vec{r},\vec{R})$
Rozwia postac elektro	ązania dla pełnego hamiltonianu układu elektronów i jąder (jonów) poszukujemy teraz w i kombinacji liniowej $\Psi^k_{el}(ec{r},ec{R})$ odpowiadających różnym możliwym funkcjom onowym:
	$\Psi(\vec{r},\vec{R}) = \sum_{k} \chi^{k}(\vec{R}) \Psi^{k}_{el}(\vec{r},\vec{R})$
Operat	tory pędu dla jonów będą działały także na $\Psi^k_{el}(ec{r},ec{R})$:
	$H(\vec{r},\vec{R})\Psi(\vec{r},\vec{R}) = [\hat{T}_N + E_{el}^k(\vec{R}) + G(\vec{R})]\Psi(\vec{r},\vec{R}) =$
	$= \sum_{k=2}^{k} \{ \Psi_{el}^{k}(\vec{r},\vec{R}) \left \sum_{N} \frac{P_{N}^{2}}{2M_{N}} + E_{el}^{k}(\vec{R}) + G(\vec{R}) \right \chi^{k}(\vec{R}) +$
	$+\sum_{N}\frac{n^{2}}{2M_{N}}\left[2\nabla_{R_{N}}\chi^{k}(\vec{R})\nabla_{R_{N}}\Psi^{k}_{el}(\vec{r},\vec{R})+\chi^{k}(\vec{R})\Delta_{R_{N}}\Psi^{k}_{el}(\vec{r},\vec{R})\right]\}$
2013-06-0	02



Równowagowy układ położeń jąder/jonów (równowagowa wartość stałej sieci) odpowiada minimum efektywnego potencjału dla ruchu jąder:

$$U_{eff}^{k}(\vec{R}) = E_{el}^{k}(\vec{R}) + G(\vec{R}) \approx U_{eff}^{k}(\vec{R}_{0}) + U_{eff}^{\prime k}(\delta\vec{R})$$

Energia potencjalna sieci zawieraja człony co najmniej kwadratowe we względnych przesunięciach jonów . Ograniczenie się do członów kwadratowych daje nam obraz drgań sieci jako zbioru sprzężonych oscylatorów harmonicznych. Dołożenie wyższych członów rozwinięcia daje efekty anharmoniczne (np. rozszerzalność termiczną, oddziaływanie fonon-fonon)

2013-06-02



Naprężenie		
Zgodnie z prawem Hooke'a dla do proporcjonalne do naprężenia:	ostatecznie małych deforma	acji odkształcenie jest wprost
[S] = [powierzchnia]/[siła] [S] = [objetość]/[energia]	$e_{xx} = S_{11}X_x + S_{12}Y_y + S_{12}$ $e_{yy} = S_{21}X_x + S_{22}Y_y + S_{23}$ $e_{zz} = S_{31}X_z + S_{32}Y_y + S_{33}$	$\begin{aligned} &z_{z} + S_{14}T_{z} + S_{15}Z_{x} + S_{16}X_{y}, \\ &z_{z} + S_{24}Y_{z} + S_{25}Z_{x} + S_{26}X_{y}, \\ &z_{z} + S_{34}Y_{z} + S_{35}Z_{x} + S_{36}X_{y}, \end{aligned}$
lub notacja $arepsilon_{kl}=S_{klij}\sigma_{ij}$	$e_{yz} = S_{41}X_x + S_{42}Y_y + S_{43}$ $e_{zx} = S_{51}X_x + S_{52}Y_y + S_{53}$ $e_{xy} = S_{61}X_x + S_{62}Y_y + S_{63}$	$\begin{split} _{3}Z_{z} + S_{44}Y_{z} + S_{45}Z_{x} + S_{46}X_{y}, \\ _{3}Z_{z} + S_{54}Y_{z} + S_{55}Z_{x} + S_{56}X_{y}, \\ _{3}Z_{z} + S_{64}Y_{z} + S_{65}Z_{x} + S_{66}X_{y}. \end{split}$
Zatem składowe naprężenia są lir	nowymi funkcjami składowy	ych odkształcenia:
$\begin{aligned} X_x &= C_{11}e_{xx} + C_{12}e_{yy} + C_{13}e_{zz} + \\ Y_y &= C_{21}e_{xx} + C_{22}e_{yy} + C_{23}e_{zz} + \end{aligned}$	$C_{14}e_{yz} + C_{15}e_{zx} + C_{16}e_{xy},$ $C_{24}e_{yz} + C_{25}e_{zx} + C_{26}e_{xy},$	
$\begin{split} Z_z &= C_{31} e_{xx} + C_{32} e_{yy} + C_{33} e_{zz} + \\ Y_z &= C_{41} e_{xx} + C_{42} e_{yy} + C_{43} e_{zz} + \end{split}$	$C_{34}e_{yz} + C_{35}e_{zx} + C_{36}e_{xy},$ $C_{44}e_{yz} + C_{45}e_{zx} + C_{46}e_{xy},$	[C] = [siła]/[powierzchnia] [C] = [energia]/[objetość]
$\begin{split} Z_x &= C_{51} e_{xx} + C_{52} e_{yy} + C_{53} e_{zz} + \\ X_y &= C_{61} e_{xx} + C_{62} e_{yy} + C_{63} e_{zz} + \end{split}$	$\begin{split} &C_{54}e_{yz}+C_{55}e_{zx}+C_{56}e_{xy},\\ &C_{64}e_{yz}+C_{65}e_{zx}+C_{66}e_{xy}. \end{split}$	lub notacja $\sigma_{kl} = \mathcal{C}_{klij} arepsilon_{ij}$
Ch. Kittel Wstęp do fizyki ciała stałego		
2013-06-02		



2



Fale sprężyste

analogicznie można napisać dla x-owych składowych sił działających na pozostałe powierzchnie, co prowadzi do wyrażenia na x-ową składową siły wypadkowej:

$$F_x = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}\right) \cdot \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$$

Równanie ruchu na x-ową składową wektora wychylenia $\vec{u}(\vec{r},t)$:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = (\rho \cdot \Delta V) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$
$$\rho \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}$$

Składowe tensora naprężeń σ_{ij} , w ramach liniowej teorii sprężystości dają się wyrazić przez składowe tensora odkształceń ε_{ii} (które z kolei są odpowiednimi pochodnymi wychyleń u_i)

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

oraz macierz współczynników sztywności C_{ii}





M. Baj

Fale sprężyste

Podsumowanie:

- Dla każdego kierunku rozchodzenia się fali (wersora propagacji) istnieją 3 rodzaje fal 1 "podłużna" i 2 "poprzeczne" z klasycznymi (liniowymi) relacjami dyspersyjnymi
- W ogólności wszystkie te fale mają różne prędkości
- Czasami fale poprzeczne są zdegenerowane (tzn. mają te same prędkości, a więc i takie same relacje dyspersyjne)
- Dla dowolnego kierunku propagacji fale nie są ani ściśle podłużne, ani ściśle poprzeczne

Fonony

2013-06-02

Drgania sieci krystalicznej – drgania układu dyskretnego o 3rN stopniach swobody, gdzie r – liczba atomów bazy (liczba atomów w najmniejszej komórce elementarnej), N – liczba komórek elementarnych kryształu

Nowe oznaczenia, wprowadzające explicite:

• numerowanie komórek elementarnych $\vec{n}=(n_1,n_2,n_3),\,n_i=1,2,3\ldots N_i,\,N_1N_2N_3=N$ gdzie położenie komórki dane jest wektorem:

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$

• numerowanie atomów w bazie $\alpha = 1, 2, ..., r$

• wychylenia atomów z położeń równowagi: $\vec{u}_{\vec{n}\alpha}$ oznacza wychylenie z położenia równowagi atomu α znajdującego się w komórce elementarnej opisanej wektorem \vec{n}

M. Baj

M. Baj

Fonony

2013-06-02

Przy omawianiu przybliżenia Borna-Oppenheimera doszliśmy do wniosku, że ruch jonów/jąder atomowych odbywa się w efektywnym potencjale: gdzie jest adiabatycznym wkładem elektronów w energię ruchu jonów/jąder, a jest zbiorem wektorów położeń wszystkich jonów/jąder

Równowagowy układ położeń jąder/jonów (równowagowa wartość stałej sieci) odpowiada minimum efektywnego potencjału dla ruchu jąder:

$$U_{eff}^{k}\left(\vec{R}\right) = E_{el}^{k}\left(\vec{R}\right) + G\left(\vec{R}\right) \approx U_{eff}^{k}\left(\vec{R}_{0}\right) + U_{eff}^{\prime k}\left(\delta\vec{R}\right)$$

 $E_{el}^{k}(\vec{R})$ jest adiabatycznym wkładem elektronów w energię ruchu jonów/jąder, a $\vec{R} = (\vec{R}_{1}, \vec{R}_{2}, \vec{R}_{3}, \vec{R}_{4}, ...)$ jest zbiorem wektorów położeń wszystkich jonów/jąder

Energia potencjalna sieci zawieraja człony co najmniej kwadratowe we względnych przesunięciach jonów . Ograniczenie się do członów kwadratowych daje nam obraz drgań sieci jako zbioru sprzężonych oscylatorów harmonicznych. Dołożenie wyższych członów rozwinięcia daje efekty anharmoniczne (np. rozszerzalność termiczną, oddziaływanie fonon-fonon).

Fonony Atom a una una nth elementary cell $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ $\vec{R}_{n\alpha} = \vec{R}_n + \vec{R}_{\alpha}$ $\vec{R}_n = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$ (0.0.0) Fig. 4.1. Explanation of the vector nomenclature used to describe lattice vibrations in a three-dimensional periodic crystal: The lattice vector r_n extends from an arbitrarily chosen lattice point (0,0,0) to the origin of the *n*th unit cell $n = (n_1, n_2, n_3)$, from which the positions of the atoms α are described by the vector \mathbf{r}_{α} . The displacement from equilibrium of Ibach, Luth atom α in cell n is then $u_{n\alpha}$. Thus the time-dependent position of this atom relative to 2013-06-02 (0,0,0) is $\mathbf{r}_{\mathbf{n}\alpha} + \mathbf{u}_{\mathbf{n}\alpha}(t)$ where $\mathbf{r}_{\mathbf{n}\alpha} = \mathbf{r}_{\mathbf{n}} + \mathbf{r}_{\alpha}$

M. Baj

Fonony

Zmieniając oznaczenie energii $U_{eff}^k(\vec{R})$ na $\Phi(\vec{R})$ (kolizja z $\vec{u}_{\vec{n}\alpha}$) i rozwijając na szereg z dokładnością do członów kwadratowych w wychyleniach (**przybliżenie harmoniczne**) otrzymujemy:

$$U_{eff}^{k}(\vec{R}) \equiv \Phi(\vec{R}) = \Phi(\vec{R}_{0} + \delta\vec{R}) = \Phi(\vec{R}_{0}) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\vec{n} \,\alpha \, i \\ \vec{m} \,\beta \, j}} \frac{\partial^{2} \Phi}{\partial x_{\vec{m} \alpha i} \partial x_{\vec{m} \beta j}} u_{\vec{n} \alpha i} u_{\vec{m} \beta j}$$

gdzie i oraz j oznaczają składowe kartezjańskie odpowiednich wektorów

"Stałe siłowe":

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_{\vec{n}\alpha i} \partial x_{\vec{m}\beta j}} \equiv \Phi_{\vec{n}\alpha i}^{\vec{m}\beta j}$$

muszą być niezmiennicze względem operacji translacji sieciowych i operacji grupy punktowej kryształu i zależą tylko od względnego położenia komórek. Np. warunek niezmienniczości względem translacji sieci:

$$\Phi_{\vec{n}\alpha i}^{\vec{m}\beta j} = \Phi_{0\alpha i}^{(\vec{m}-\vec{n})\beta j}$$

M. Baj

Ibach, Luth

2013-06-02

Fonony

Podstawienie powyższej postaci do równania ruchu daje:

$$-\omega^2 u_{\alpha i}(\vec{q}) + \sum_{\beta j} \sum_{\vec{m}} \frac{1}{\sqrt{M_\alpha M_\beta}} \, \Phi_{\vec{n} \alpha i}^{\vec{m} \beta j} e^{i \vec{q} (\vec{k}_m - \vec{k}_n)} \, u_{\beta j}(\vec{q}) = 0$$

Oznaczamy

$$D_{\alpha i}^{\beta j}(\vec{q}) \equiv \sum_{\vec{m}} \frac{1}{\sqrt{M_{\alpha} M_{\beta}}} \Phi_{\vec{n} \alpha i}^{\vec{m} \beta j} e^{i \vec{q} (\vec{R}_m - \vec{R}_n)}$$
$$-\omega^2 u_{\alpha i}(\vec{q}) + \sum_{\vec{n} i} D_{\alpha i}^{\beta j}(\vec{q}) = 0$$

Jest to równanie liniowe, jednorodne, rzędu 3r - tzw. macierz dynamiczna. Równanie to nie zależy od \vec{n} , bo $\Phi_{\vec{n}\vec{a}i}^{\vec{m}\beta j} = \Phi_{0\alpha i}^{(\vec{m}-\vec{n})\beta j}$

Układ jednorodnych równań liniowych ma rozwiązanie własne tylko wtedy, gdy $\det \left\{ D^{\beta j}_{\sigma i}(\vec{q}) - \omega^2 \hat{1} \right\} = 0$

(3r różnych rozwiązań – numerowanie atomów w bazie $\alpha = 1, 2, ..., r$)

2013-06-02

Fonony

Równanie ruchu atomu α z komórki elementarnej \vec{n} (*i*-ta składowa):

$$M_{\alpha} \ddot{\vec{u}}_{\vec{n}\alpha} + \sum_{\vec{m}\beta j} \Phi_{\vec{n}\alpha i}^{\vec{m}\beta j} u_{\vec{m}\beta j} = 0$$

gdzie siły pochodzą od oddziaływań ze wszystkimi pozostałymi atomami. Należy zwrócić uwagę, że przeważnie w tym równaniu wystarczy się ograniczyć do stałych siłowych związanych z oddziaływaniem z bliskimi sąsiadami

Rozwiązania, zależnego wyłącznie od położenia danej komórki elementarnej, poszukujemy w postaci fal płaskich:

$$u_{\vec{n}\alpha i} = \frac{1}{\sqrt{M_{\alpha}}} u_{\alpha i}(\vec{q}) e^{i(\vec{q}\vec{R}_n - \omega t)}$$

Dla $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ mamy $\vec{R}_n = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$

(wstawiamy teraz do równania ruchu)





Fonony

W równowadze z termostatem o temperaturze T obsadzenie stanu fononowego (średnia liczba fononów w danym stanie fononowym):

$$\left\langle n_{S\vec{q}}(T)\right\rangle = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega_{S}(\vec{q})}{kT}} - 1} \xrightarrow{T \to \infty} \left(\frac{kT}{\hbar\omega_{S}(\vec{q})}\right) \propto T$$

w wysokich temperaturach liczba fononów jest proporcjonalna do temperatury.

Podobnie jak dla elektronów gęstość stanów fononowych w przestrzeni wektora (patrz poprzedni wykład - gęstość stanów elektronowych) jest stała i wynosi (3D):

$$\rho(\vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3}$$

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony

Dla każdego \vec{q} otrzymujemy 3r niezależnych drgań normalnych (**modów własnych**) w postaci fal. Mamy więc 3r relacji dyspersyjnych dla różnych rodzajów fal i 3rN **jednowymiarowych** oscylatorów harmonicznych.

kwantowanie oscylatorów \Rightarrow oscylatory "numerowane" numerem **gałęzi** s (jest ich 3r) oraz wektorem falowym \vec{q} :

$$E_{osc} = \left(n_{s\vec{q}} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega(\vec{q})$$

kwant wzbudzenia danego oscylatora nazywamy **fononem** (kwazicząstka). Stan kwantowy fononu opisują liczby kwantowe s i \vec{q} . Dowolnie dużo fononów może obsadzać ten sam stan kwantowy (bo dany oscylator może być w dowolnie wysokim stanie kwantowym) \Rightarrow **fonon jest bozonem**:

Energia $E_{sec q}$ fononu: Kwazipęd ec p fononu: $E_{s\vec{q}} = \hbar\omega(\vec{q})$ $\vec{p} = \hbar\vec{q}$

Fonony

2013-06-02

2013-06-02

Fonony akustyczne w $\vec{q}=0$ odpowiadają drganiom wszystkich r atomów bazy w zgodnych fazach (brak momentu dipolowego związanego z drganiami).

W przypadku **fononów optycznych**, jeśli atomy bazy nie są jednakowe, takie momenty dipolowe się pojawiają – możliwe sprzężenie z falą elektromagnetyczną: dla kryształów jonowych silna absorpcja dla częstości odpowiadających fononom optycznym (Reststrahlen)

W ogólności (dla dowolnego \vec{q}) ani gałęzie "poprzeczne" ani "podłużne" nie odpowiadają ściśle drganiom poprzecznym i podłużnym (patrz fale sprężyste w ośrodkach ciągłych)

W przybliżeniu harmonicznym fonony są kwazicząstkami całkowicie ze sobą nieoddziałującymi

Wyjście poza przybliżenie harmoniczne pozwala np. zrozumieć : • skąd się bierze rozszerzalność termiczna

- dlaczego (fononowe) przewodnictwo cieplne jest skończone
- Oddziaływania fonon-fonon (rozpraszanie)

Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q}=0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Fonony	
Relacja Lyddane'a–Sachsa–Tellera $\frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)} = \frac{\omega_{LO}^2}{\omega_{TO}^2} \qquad \begin{array}{c} \text{Do tego wrócimy} \\ \text{przy dyskusji } \varepsilon(\omega) \\ \text{przy dyskusji } \varepsilon(\omega) \end{array}$ Gdzie $\varepsilon(0)$ i $\varepsilon(\infty)$ są niskoczęstościową i wysokoczęstościową stałą dielektryczną.	
Efektywny, poprzeczny ładunek Borna: Jedna z "dynamicznych" definicji ładunku efektywnego $e^* = \omega_{TO} \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \mu}{N} (\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty))}$	
gdzie μ jest masą zredukowaną, a N – koncentracją drgających par atomów	
2013-06-02	31

Fonony

W krysztale z bazą składająca się z r atomów mamy 3 gałęzie **fononów akustycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) = 0$ (1 "podłużnych" LA i 2 "poprzecznych" TA) oraz 3r - 3 gałęzi **fononów optycznych**, dla których $\omega_s(\vec{q} = 0) \neq 0$ (r - 1 "podłużnych" LO i 2r - 2 "poprzecznych" TO)



Pojemność cieplna

Doświadczalna obserwacja – w wysokich temperaturach molowe ciepło przy stałej objętości $C_V = 3R$. Jest to zgodne z modelem klasycznym i zasadą ekwipartycji energii – prawo Dulonga-Petita (~ $3N_A$ jednowymiarowych oscylatorów na mol, na każdy wypada średnio kT energii \Rightarrow molowa pojemność cieplna 3RT). Jednak w niskich temperaturach $T \rightarrow 0$ w niemetalach $C_V \sim T3$ (a prawo Dulonga-Petita przewiduje $C_V = const$)

Wkład fononów do energii wewnętrznej (na jednostkę objętości, bo $\rho(\vec{q})$ jest liczone na jednostkę objętości):

$$U(T) = \sum_{s} \int_{1SB} \hbar \omega_{s}(\vec{q}) \langle n_{s\vec{q}}(T) \rangle \rho(\vec{q}) d^{3}q$$

gdzie s numeruje gałęzie fononów

2013-06-02

Znajomość relacji dyspersyjnych dla wszystkich gałęzi fononowych pozwala znaleźć U(T) i ciepło przy stałej objętości liczone na jednostkę objętości:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_T$$

Dwa proste modele fononowego wkładu do pojemności cieplnej sieci krystalicznej – Einsteina i Debya:

Pojemność cieplna

Model Einsteina:

W równowadze z termostatem o temperaturze T obsadzenie stanu fononowego (średnia liczba fononów w danym stanie fononowym):

$$\langle n_{s\vec{q}}(T) \rangle = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega_s(\vec{q})}{kT}} - 1}$$

Zbiór 3N oscylatorów kwantowych, wszystkie o jednakowej energii $\hbar\omega_0$ (model w przybliżeniu słuszny dla fononów optycznych dla których $\omega(\vec{q}) \approx const$)

$$U(T) = 3N \cdot \hbar \omega_0 \cdot \langle n(T) \rangle = 3N \cdot \hbar \omega_0 \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_s(\vec{q})}{kT}} - 1}$$

jeśli wziąć $N = N_A$, to molowe ciepło:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_T = 3R \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \stackrel{x \to 0}{\longrightarrow} 3R$$

 $x = \frac{\hbar\omega_0}{kT}$ gdzie w ten sposób odtwarzamy prawo Dulonga-Petita, ale w niskich temperaturach orzymuje się zależność szybszą niż doświadczalna

2013-06-02

Pojemnoś	ć	cieplna	
Model Debye'a: fonony akustyczne z upr $\omega_{TA} = u_T q$ (2 gałęzie) $\omega_{LA} = u_L q$ (1 gałąź)	roszci	zoną (liniową) dyspersją:	
wszystkie 3 gałęzie (zakł Stad $\omega_n = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot u$	adaja	ac degenerację obu gałęzi poprzeczny $\rho(\omega) = \frac{\omega^2}{2\pi^2} \left(\frac{2}{u_T^3} + \frac{1}{u_L^3}\right) \equiv \frac{3\omega^2}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{u_L^3}$	rch):
	Density of states Z(v)	Silicon Debye approximation	Ibach, Luth Fig. 5.2. Phonon density of states of Si [5.1] (Fig. 4.4). The dashed line is the den- sity of states that one would obtain for an elastic isotro- pic continuum (Debye ap-
2013-06-02		4 ο 12 16 Frequency ν (10 ¹² s ⁻¹)	proximation with $\Theta = 640$ K; Sect. 5.3) 35

Descent the end of the end of

Pojemność cieplna
Model Debye'a: $3N = \int_{0}^{\omega_D} \rho(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{\omega_{max}^3}{u^3}$ Stąd $\omega_D = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot u$
Definicja temperatury Debye'a : $\Theta = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot \frac{\hbar u}{k_B}$
Wkład fononów do energii wewnętrznej (na jednostkę objętości): $U(T) = \int_{0}^{\omega_{p}} \hbar\omega \rho(\omega) \langle n(\omega,T) \rangle d\omega = \frac{3}{2\pi^{2}} \cdot \frac{\hbar}{u^{3}} \int_{0}^{\omega_{p}} \frac{\omega^{3}}{e^{kT} - 1} d\omega =$ $= \frac{3}{2\pi^{2}} \cdot \frac{\hbar}{u^{3}} \cdot \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^{4} \cdot \int_{0}^{\frac{\Theta}{T}} \frac{x^{3}}{e^{x} - 1} dx = \frac{3}{2\pi^{2}} \cdot \hbar u \cdot \left(\frac{kT}{\hbar u}\right)^{4} \cdot \int_{0}^{\Theta/T} \frac{x^{3}}{e^{x} - 1} dx$
2013-06-02 36

Pojemność cieplna

Model Debye'a:

Otrzymujemy wkład fononów (akustycznych) do energii wewnętrznej wg. modelu Debye'a

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right) = 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \int_0^{\theta/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

Niskie temperatury:

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right)\approx 9Nk\Theta\cdot\left(\frac{T}{\Theta}\right)^4\cdot\frac{\pi^4}{15}{\sim}T^4$$
Zgodnie z doświadczeniem $C_V{\sim}T^3$

Wysokie temperatury:

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right) \approx 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \int_{0}^{\frac{T}{T}} \frac{x^3}{1+x-1} dx = 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{\Theta}{T}\right)^3 = 3NkT$$

Prawo Dulonga-Petita $C_V = 3R$, jeśli policzymy U dla N_A oscylatorów.









Równanie *kp* – masa efektywna

Równanie Schrodingera na obwiednię $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m}\,\vec{k}\hat{p} + V(\vec{r})\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(E - \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Jest to tzw. równanie kpwykorzystywane do obliczeń energii i funkcji falowych wokół pewnego znanego rozwiązania dla $\vec{k}=\vec{k}_0.$

Pełny hamiltonian

$$\hat{H}_{\vec{k}}u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(\hat{H}_{\vec{k}_0} + \hat{H}'\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = E_n(\vec{k})u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Zaburzenie:

$$\widehat{H}' = \frac{\hbar}{m} \left(\vec{k} - \vec{k}_0 \right) \hat{p}$$

Funkcję $u_{n,ec{k}}(ec{r})$ oraz energię $E_n(ec{k})$ znajdujemy w rachunku zaburzeń





$\begin{aligned} & \mathsf{F}(\vec{k}) = \left(E_n - \frac{h^2 \vec{k}^2}{2m}\right) \text{ wokot punktu ekstremalnego, p. } k = 0; \\ & \mathcal{E}_n(\vec{k}) = \mathcal{E}_n(0) + H'_{nn} + \sum_{l \neq n} \frac{|H'_{nl}|^2}{E_n(0) - E_l(0)} + \cdots \end{aligned} \\ & \mathsf{D}_n(\vec{k}) = \mathcal{E}_n(0) + H'_{nn} + \sum_{l \neq n} \frac{|H'_{nl}|^2}{E_n(0) - E_l(0)} + \cdots \\ & \mathsf{D}_n(\vec{k}) = \int_{u_{n,0}} (\vec{r}) \hat{H}' \, u_{l,0}(\vec{r}) \, d^3r = -\frac{i\hbar}{m} \frac{\vec{k}}{k} \int u_{n,0}(\vec{r}) \nabla u_{l,0}(\vec{r}) \, d^3r = \sum_{l=1}^3 a_l k_l \\ & \mathsf{Liniowe w} \vec{k} \end{aligned}$

Równanie *kp* – masa efektywna

Energia $E_n(\mathbf{k})$ wokół ekstremum dla kryształu jednoosiowego (np. GaN):

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2 + k_2^2}{m_{\perp}^4} + \frac{k_3^2}{m_{\parallel}^8} \right)$$

Dla kryształu kubicznego:

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + rac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$
 tzw. pasmo sferyczne

W pobliżu ekstremum (np. punkt $\Gamma(k=0)$) możemy ograniczyć się do przybliżenia parabolicznego – pasmo parabloczne.

W ogólności w zależności energii od wektora falowego występują człony wyższego rzędu, które zostały zaniedbane (wyższe rzędy rachunku zaburzeń).

W ogólności energia elektronu jest funkcją składowych wektora falowego $k = (k_1, k_2, k_3)$. Powierzchnia stałej energii w ogólnym przypadku może mieć skomplikowany charakter, a jej kształt zależy od wszystkich pasm.

Badanie tensora masy efektywnej to jeden z głównych problemów fizyki ciała stałego.

Eddemain
$$p_n(\vec{k}) = p_n(0) + \sum_{l=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{1}{m_{ij}^2}\right) \frac{\hbar^2 k_l k_j}{2} + \cdots$$
Wrowadzamty tzw. tensor odwrotności masy efektywnej: $\frac{1}{m_{ij}^2} = \frac{\delta_{ij}}{m} + \frac{2\hbar^2}{m^2} \sum_{l\neq n} \frac{\int u_{n,0} \frac{\partial}{\partial x_i} u_{l,0} d^3 r \cdot \int u_{n,0} \frac{\partial}{\partial x_j} u_{l,0} d^3 r}{E_n(0) - E_l(0)}$ Tensor jest symetryczny ($m_{ij} = m_{jl}$). Jeśli ekstremum energii jest w punkcie $\Gamma(k=0)$ to
to owierzchnia stałej energii jest elipsoidą w przestrzeni k, która po sprowadzeniu do osi
gównych ma postać: $\mu_n(\vec{k}) \approx E_n(0) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2}{m_1^4} + \frac{k_2^2}{m_2^4} + \frac{k_3^2}{m_3^4}\right)$ Otzie m_i^* to masy efektywne w kierunku osi głównych.





Mode	ciasnego wiązani	a (LCAO)	
Dla struktury s $\int \varphi_j^*(\vec{r} - \vec{R}_m) [V'(\vec{r} - \vec{R}_m)] \varphi_j(\vec{r} - \vec{R}_m) \varphi_j(\vec{r} - \vec{R}_m)$	Sc: $\vec{R}_n - \vec{R}_m = (\pm a, 0, 0); (0, \pm a, 0); (0, 0, \pm a, $	Fig. 7.10. The four highest occupied energy bands of KCI calcu-	Litth, Solid-State Physics
$B_j = 0$		separation in Bohr radii ($a_0 = 5.29 \times 10^{-9}$ cm). The energy levels in the free ions are indicated by	H. Ibach, I
2013-06-02	ion separation in Bohr radii	arrows. (After [7.2])	51



PassesWorksenseWorksenseWorksenseArmo utworzone jest głównie ze stanów typu p (tzn. L=1) anionuGeneracja (z uwzględnieniem spinu) jest zniesiona przez oddziaływanie spin-orbitaImage: Start Star







Rozważmy atomowe stany $p: x\rangle, y\rangle, z\rangle$ utworze na oś $z:$ $\begin{cases} x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1\rangle - 1, 1\rangle) \\ y\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} (1, -1\rangle + 1, 1\rangle) \\ z\rangle = 1, 0\rangle \end{cases}$ Oddziaływanie spin-orbita $\lambda \hat{L} \hat{S}$ prowadzi do teg m_j i właściwą bazą stają się funkcje $ j, m_j\rangle = \frac{3}{2}$	one z operatora rzutu momentu pędu $ l, m_l\rangle$ $\begin{cases} 1, -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(x\rangle - i y\rangle) \\ 1,0\rangle = z\rangle \\ 1,1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x\rangle + i y\rangle) \end{cases}$ go, że dobrymi liczbami kwantowymi stają się m_j , $\frac{1}{2}, m_j$:
--	--

Pasmo walencyjne

Oddziaływanie spin-orbita $\lambda \hat{L} \hat{S}$ prowadzi do tego, że dobrymi liczbami kwantowymi stają się *j* i m_j i właściwą bazą stają się funkcje $|j, m_j\rangle = |\frac{3}{2}, m_j\rangle, |\frac{1}{2}, m_j\rangle$:

$$\left| \frac{3}{2}, m_j \right| = \begin{cases} \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right| = |1, -1\rangle \downarrow \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1, -1\rangle \uparrow + \sqrt{2} |1, 0\rangle \downarrow \right) \\ \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1, 1\rangle \downarrow + \sqrt{2} |1, 0\rangle \uparrow \right) \\ \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right| = |1, 1\rangle \uparrow \\ \left| \frac{1}{2}, m_j \right| = \begin{cases} \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1, 0\rangle \downarrow - \sqrt{2} |1, -1\rangle \uparrow \right) \\ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1, 0\rangle \uparrow - \sqrt{2} |1, 1\rangle \downarrow \right) \end{cases}$$
2013-06-02

Pasmo walencyjne	Yu, Cardona Fundamenials of semiconductors
<page-header><text><text><equation-block><text><text><text><text><text><equation-block><equation-block></equation-block></equation-block></text></text></text></text></text></equation-block></text></text></page-header>	<page-header><text><equation-block><text></text></equation-block></text></page-header>

Descent
Basic
Matrix
Marking the spin-orbita $\lambda \hat{L} \hat{S}$ prowadzi do tego, že dobrymi liczbami kwantowymi stają się j
 m_j i właściwą bazą stają się funkcje $|j, m_j\rangle = |\frac{3}{2}, m_j\rangle, |\frac{1}{2}, m_j\rangle$.Taka samą procedurę możemy przeprowadzić dla funkcji stanów elektronowych pasma
walencyjnego z punktu $\Gamma : [x), [y), [z)$, które transformują się pod działaniem operacji grupy
uputkowej kryształu jak atomowe stany p. Będziemy wtedy mówili o p-podobnych stanach, at
także, po przeprowadzeniu takiej samej operacji jak przy tworzeniu atomowych funkcji
 (j, m_j) (przy dodaniu S - 0), o (j = 3/2)-podobnych stanach czy (j = 1/2)-podobnych
stanachTakich – podobnych stanów można teraz użyć jako bazy do diagonalizacji hamiltonianu kpWniki takiej procedury (uwzględniającej wyższe pasma w 2. rzędzie rachunku zaburzeń):

ile marcheyjne	Yu, Cardona Fundamenials of semiconduc
2. Electronic Band Structures	2.6 The kp Method of Band-Structure Calculation
The expansion of the eigenvalue to seem of the order of k^2 only, the fact and the expansion of the eigenvalue to seem of the mode of k^2 only, the energy of the back material $k^2 = 1/2$. The set as $K_{w} = k \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} $	$\begin{pmatrix} m_{i} \\ m_{i} \end{pmatrix}^{(2)} = \frac{M_{i} M_{i}^{(2)}}{8\pi (2-d_{i})}$. (2.A) Figuritors (2.A-63) how thet it is error correction to define the correstance R_{i} and C into a common is used a abbreviation R_{i} which is the fitter R_{i} which is the intermediate R_{i} and C into a common is used a abbreviation R_{i} which is the fitter R_{i} which R_{i}
$(H_{11}^{i} - E)(H_{22}^{i} - E) = H_{12}^{2} + H_{23}^{2}$ (2.60)	the writers as 2.5, and 2.5, while the corresponding time contracts a contract of the contract
and their solutions are $F = 1(H'_{-} + H'_{-}) + \frac{1}{2} [(H'_{-} + H'_{-})^2 - 4(H'_{-}H'_{-} - H^2_{-})]^2,$ (2.61)	$E_{igh} = -Ak^{2} - [B^{2}k^{2} + C^{2}(k_{2}^{2}k_{j}^{2} + k_{j}^{2}k_{i}^{2} + k_{j}^{2}k_{i}^{2} + k_{j}^{2}k_{i}^{2})]^{2},$ (2.86a) $E_{i} = -Ak^{2} + 10^{2}k^{4} + C^{2}(k^{2}k^{2} + k^{2}k^{2} + k^{2}k^{2})]^{2}$ (2.66b)
$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} $	Constant correspondences and the second sec

Pasmo walencyjne



									<u> </u>	
no Γ_7 odszczepione	spin-c	orbitalı	nie							
$\hbar^2 k^2$	2 (Р	2		20^{2}					
$A_{0} = -\Delta_{0} + \frac{1}{2m}$	$-\frac{1}{2}$	ma (E	1 4)	$+\frac{1}{m}$	E' 1	<u> </u>				
2111	2 (i	$m(E_0$	$+ \Delta_0$	m($E_0 + I$	$\Delta_0) /]$				
i pasma $arGamma_8$ (dziury o	iężkie	i lekki	e)							
$= Ak^{2} \pm B^{2}k^{4} $	+ C²(k	$k_x^2 k_y^2 +$	$+k_v^2k$	$\frac{2}{z} + k_x^2$	k_z^2)					
N N	`		-							
								hard free	Relia to a	mite of
Table 2	24. Vale	nce ban	d paran	neters A	and B	in units	of (h ⁴ /	m) and	$ C ^{r}$ in under the set of a	mits of
Table 2 $(\hbar^2/2m)$	24. Vale 2. The sp	nce ban vin-orbit	d paran splittin	neters A	and B valence	in units bands	of $(\hbar^2/2)$ Δ_0 is gi	(m) and ven in u	C ² in u nits of e with (2)	units of V. The
Table 2 (h ² /2m) average	.24. Vale ² . The sp d experin	nce ban sin-orbit nental (o	d paran splittin exp) and	neters A g of the d theoreti	and B valence ical [th, / hole (t	in units bands obtaine ah), ligh	of $(\hbar^{4/2})$ Δ_0 is given a d from a t hole (II)	(<i>m</i>) and ven in u A, B, C^2 (i) and sp	C [≠] in u nits of e with (2.0 in−orbit s	units of V. The 67, 69)] split-off
Table 2 ($\hbar^2/2m$) average values of hole (so	24. Vale 2. The sp d experin of the effe) valence	nce ban sin-orbit mental (o ective ma bands a	d paran splittin exp) and asses of re in uni	neters A g of the d theoreti the heavy its of the	and B valence ical [th, hole (the free electricity of the second	in units bands obtaine ah), ligh ctron m	of $(\hbar^2/2 \Delta_0$ is given by Δ_0 is given by the from λ the form λ the form λ the form λ of the form λ as so, (2.11)	(<i>m</i>) and ven in u <i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> ² (1) and sp (12)	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit	units of V. The 67, 69)] split-off
Table 2 (h²/2m) average values of hole (so	24. Vale 2. The sp d experin of the effe) valence	nce ban sin-orbit mental (ective ma bands a	d paran splittin exp) and isses of re in uni	neters A g of the d theoreti the heavy its of the	and B valence ical [th, / hole (th free electronic)	in units bands obtaine ah), ligh ctron m	of $(\hbar^{d}/2 \Delta_0$ is given that Δ_0 is given that the form Δ_0 is the form Δ_0 of the form Δ_0	(<i>m</i>) and ven in u (<i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> ² (<i>a</i>) and sp (<i>a</i> , 12)	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit	units of V. The 67, 69)] split-off
Table 2 (h²/2m) average values 6 hole (so (so	24. Vale ² . The sp d experir of the effe) valence A	nce ban sin-orbit nental (e ective ma bands a B	d paran splittin exp) and isses of re in uni	neters A g of the d theoreti the heavy its of the An	and B valence ical [th, / hole (t free ele-	in units bands obtaine ah), ligh ctron m	of $(\hbar^4/2)$ Δ_0 is given by those (line) ass. (2.11)	(<i>m</i>) and ven in u 4, <i>B</i> , <i>C</i> ² i) and sp , 12)	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit s	units of V. The 67, 69)] split-off
Table 2 (h²/2m) average values values hole (so	24. Vale ² . The sp d experin of the effe) valence A	nce ban bin-orbit mental (c ective ma bands a B	d paran splittin exp) and sses of re in uni	neters A g of the d theoreti the heavy its of the A_0 [eV]	and B valence ical [th, / hole (h free ele- ma exp	in units bands obtaind ah), ligh ctron m a(mo th	of $(\hbar^2/2)$ Δ_0 is gived from Δ_0 thole (lift ass. (2.11) D_0 exp.	(<i>m</i>) and ven in u <i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> ² h) and sp , 12) <i>(m)</i> th	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit s m _{exp}	units of V. The 67, 69)] split-off /m th
Table 2 (k ² /2m) average values 5 hole (so	24. Vale ² . The sp d experind of the effective (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	nce ban bin-orbit mental (e etive ma bands a B	d paran splittin exp) and sses of re in uni	neters A g of the d theoreti the heavy its of the An [cV] 0.044	and B valence ical [th. hole (the free electronic mathematics exp 0.54	in units bands obtaind ah), ligh ctron m s(mo th 0.45	of (h ⁴ /2 d ₀ is gi d from a t hole (ll ass. (2.11 m) exp 0.15	(<i>m</i>) and ven in u (<i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> ² a) and sp (<i>1</i> 2) (<i>m</i>) (<i>h</i>) (<i>h</i>)	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit s m _{exp} 0.23	units of V. The 67, 69)] split-off (m th 0.24
Table 2 (k ² /2m) average values o hole (so Si Ge	24. Vale ² . The sp d experind of the effective valence A -4.25 -13.4	nce ban bin-orbit mental (o ctive ma bands a B -0.63 -8.5	d paran splittin exp) and asses of t re in uni (C) ² 24 173	and the set of the set	and B valence ical [th, hole (th free elec ma exp 0.54 0.34	in units bands obtainc ah), ligh ctron m (m) th 0.45 0.43	of (h ⁴ /2 <u>A</u> ₀ is gi ad from <u>A</u> t hole (ll ass. (2.11 <u>D</u>) <u>exp</u> 0.15 0.043	(m) and ven in u A, B, C ² n) and sp , 12) (m) (b) 0.14 0.041	C ² in t nits of e with (2.0 in-orbit s m _e , exp 0.23 0.095	units of V. The 67, 69)] split-off /m ₀ th 0.24 0.1
Table 2 (k ² /2m) average values 5 hole (so Si Ge	24. Vale ² . The sp d experim of the effe) valence A -4.25 -13.4 -7.0	nce ban pin-orbit nental (c ective ma bands a B -0.63 -8.5 -4.5	d paran splittin exp) and ssses of 1 re in uni (C) ² 24 173 38	and the set of the set	and B valence ical [th, hole (th free elec matrix 0.54 0.54 0.53	in units bands obtaine ah), ligh ctron m b 0.45 0.43 0.78	a of $(h^2/2)$ Δ_0 is given by Δ_0 is given by Δ_0 is given by Δ_0 is given by Δ_0 is a given	(m) and ven in u A, B, C ² h) and sp , 12) (m) 11 0.14 0.041 0.08	C * in t nits of e with (2.4 in-orbit s m _e , exp 0.23 0.095 0.15	units of V. The 67, 69)] split-off (mo th 0.24 0.1 0.17
Table 2 (h ² /2m) average values < hole (so Ge Ga Si Ge Ga Si to P	24. Vale ² . The sp d experin of the effe) valence A -4.25 -13.4 -7.0 -5.04	nce ban pin-orbit mental (ective material bands a B -0.63 -8.5 -4.5 -3.1	d paran splittin exp) and ssses of 1 re in uni (C) ² 24 173 38 41	neters A g of the d theoreti the heavy its of the eV 0.044 0.295 0.341 0.11	and B valence ical [th, hole (th free elec matrix 0.54 0.54 0.53 0.58	in units bands obtaine ah), ligh ctron m b 0.45 0.43 0.78 0.53	a of (h ² /2 <i>A</i> ₀ is gi <i>A</i> ₀ from <i>t</i> hole (ll ass. (2.11)) (xp) 0.15 0.043 0.08 0.12	(m) and ven in u A, B, C ² h) and sp . 12) h 0.14 0.041 0.08 0.12	C ² in t nits of e with (2.1 in-orbit s m _e , csp 0.23 0.095 0.15 0.12	units of V. The 67, 69)] split-off (mo th 0.24 0.1 0.17 0.2
Table 2 (k ² /2m) average values c hole (so Si Ge GaAs InP	24. Vale ² . The specified expering of the effective valence -4.25 -13.4 -7.0 -5.04 -20.4	nce ban pin-orbit mental ($e_{eetive max}$ bands a B -0.63 -8.5 -4.5 -3.1 -16.6	d paran splittin exp) and ssses of re in uni (C) ² 24 173 38 41 167	neters A g of the d theoreti the heavy its of the 24n [eV] 0.044 0.295 0.341 0.11 0.38	and B valence ical (th. / hole (t) free elec exp 0.54 0.54 0.53 0.58 0.4	in units bands obtaind ah), ligh ctron m 0.45 0.43 0.78 0.53 0.4	a of (h ⁴ /2 <i>A</i> ₀ is gi <i>A</i> from <i>A</i> t hole (ll ass. (2.11)) (Stp 0.15 0.043 0.08 0.12 0.026	(<i>m</i>) and ven in u 4. <i>B</i> , <i>C</i> ² a) and sp , 12) (<i>m</i>) (<i>m</i>	C ² in u nits of e with (2.0 in-orbit s m _e , exp 0.23 0.095 0.15 0.12 0.14	units of V. The 67, 69)] split-off (mo th 0.24 0.1 0.17 0.2 0.10
Table 2 (h ² /2m) average values s hole (so Si Ge GaAs InP InAs	24. Vale ² . The specified expering of the effective valence -4.25 -13.4 -7.0 -5.04 -20.4 -13.3	B = 0.63 - 0.63 - 8.5 - 4.5 - 3.1 - 16.6 - 8.8	d paran splittin exp) and ssses of re in uni (C) ² 24 173 38 41 167 230	neters A g of the d theoreti the heavy its of the 24n [eV] 0.044 0.295 0.341 0.38 0.75	and B valence ical (th. / hole (t free elec exp 0.54 0.54 0.53 0.58 0.4 0.8	in units bands obtaind ah), ligh ctron m 0.45 0.43 0.78 0.53 0.4 0.9	a of $(h^{4/2} \Delta_0)$ is given by the form A_0	(<i>m</i>) and ven in u 4, <i>B</i> , <i>C</i> ² h) and sp , 12) (<i>m</i> ₀) (<i>m</i> ₀)) (<i>m</i> ₀) (<i>m</i> ₀	C * in u nits of e with (2.0 in-orbit s 0.0 0.23 0.095 0.15 0.12 0.14 	units of V. The 67, 69)] split-off (mo th 0.24 0.1 0.17 0.2 0.10 0.15
Table 2 (h ² /2m) average values 4 hole (so Si Ge GaAs InP InAs GaS5 LnSh	24. Vale ² . The sp d experint of the effet o) valence A -4.25 -13.4 -7.0 -5.04 -20.4 -40.1 -40.1 -40.1 -40.1 -40.1 -40.1 -40.1 -40.1 -50.4 -40.2 -40.2 -40.2 -50.4 -40.2 -40.2 -40.2 -50.4 -40.2 -40.2 -50.4 -40.2 -50.4 -40.2 -50.4 -40.4 -50.4 -50.4 -50.4 -40.4 -50	B -0.63 -8.5 -4.5 -3.1 -16.6 -3.6 -	d paran splittin exp) and isses of 1 re in uni (C) ² 24 173 38 41 167 230 492	acters A g of the d theoreti the heavy its of the 0.044 0.295 0.341 0.11 0.38 0.75 0.81	and <i>B</i> valence ical [th, hole (th free electronic 0.54 0.53 0.53 0.4 0.8 0.42	in units bands obtainc ah), ligb ctron m 0.45 0.43 0.78 0.43 0.78 0.4 0.9 0.48	a of (b ^{4/2} <u>d₀</u> is given by the difference of the difference	(m) and ven in u A, B, C ² h) and sp , 12) (m) 11 0.14 0.08 0.12 0.041 0.04 0.04 0.04 0.04	C * in u nits of e with (2.1 in-orbit s 0.23 0.095 0.15 0.12 0.14 	units of V. The 67, 69)] split-off (m) 15 0.24 0.1 0.27 0.2 0.10 0.15 0.12



Dynamika elektronów w krysztale

Paczka falowa utworzona ze stanów *n*-tego pasma z otoczenia $\vec{k}_0 (\vec{k} = \vec{k}_0 + \vec{\xi})$ będzie tworem zlokalizowanym, ale nie będzie odpowiadała stanowi własnemu hamiltonianu:

$$\psi_n\left(\vec{r},t\right) = A \int u_{n,\vec{k}}(\vec{r})e^{i\left(\vec{k}\vec{r}-\omega t\right)} dV_k$$

energia jest ciągłą funkcją \vec{k} , zatem $\omega(\vec{k}) = \omega(\vec{k}_0) + \nabla_{\vec{k}}\omega\vec{\xi} + \cdots$ (oznaczenie: $\omega(\vec{k}_0) \equiv \omega_0$) Funkcja Blocha $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ jest wolnozmienną funkcją \vec{k}

$$\begin{split} \psi_{n}\left(\vec{r}\right) &= Au_{n,\vec{k}}\left(\vec{r}\right) \int_{\Delta V_{k}} e^{i\left(\left(\vec{k}_{0}+\vec{\xi}\right)\vec{r}-\left(\omega\left(\vec{k}_{0}\right)+\overline{\nu}_{\vec{k}}\omega\vec{\xi}\right)t\right)} d^{3}\xi = \\ &= Au_{n,\vec{k}}\left(\vec{r}\right) e^{i\left(\vec{k}_{0}\vec{r}-\omega_{0}t\right)} \int_{\Delta V_{k}} e^{i\left(\vec{\xi}\vec{r}-\left(\overline{\nu}_{\vec{k}}\omega\vec{\xi}\right)t\right)} d^{3}\xi = Au_{n,\vec{k}}\left(\vec{r}\right) e^{i\left(\vec{k}_{0}\vec{r}-\omega_{0}t\right)} \cdot J_{1} \cdot J_{2} \cdot J_{3} \\ &J_{i} = \int_{-\Delta k}^{\Delta k} e^{i\xi_{i}\left(x_{i}-\frac{\partial\omega}{\partial k_{i}}t\right)} d\xi_{i} = 2\Delta k \frac{\sin\left[\Delta k\left(x_{i}-\frac{\partial\omega}{\partial k_{i}}t\right)\right]}{\Delta k\left(x_{i}-\frac{\partial\omega}{\partial k_{i}}t\right)} = 2\Delta k \operatorname{sinc}(\alpha) \\ &\operatorname{Maksimum} \operatorname{dla} \alpha = 0. \end{split}$$

R. Stepniews

2013-06-0

Dynamika elektronów w krysztale

Funkcja Blocha zależna od czasu $\omega = E/\hbar$:

 $\Psi_{n,\vec{k}}(\vec{r},t) = \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})e^{-i\omega t} = u_{n,\vec{k}}(\vec{r})e^{i(\vec{k}\vec{r}-\omega t)}$

opisuje elektron **całkowicie zdelokalizowany** – prawdopodobieństwo znalezienia go w każdej z komórek elementarnych Ω jest takie samo:

$$\int_{\Omega} \Psi_{n,\vec{k}}^*(\vec{r},t)\Psi_{n,\vec{k}}(\vec{r},t)\,dV = \int_{\Omega} \Psi_{n,\vec{k}}^*(\vec{r})\Psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})\,e^{-i\omega t}dV = const$$

Paczka falowa utworzona ze stanów *n*-tego pasma z otoczenia \vec{k}_0 ($\vec{k} = \vec{k}_0 + \vec{\xi}$) będzie tworem zlokalizowanym, ale nie będzie odpowiadała stanowi własnemu hamiltonianu:

Dynamika elektronów w krysztale

Załóżmy, że działa siła zewnętrzna \vec{F} . Moc tej siły:

$$\vec{F}\vec{v} = \frac{dE}{dt} = \nabla_{\vec{k}}E(\vec{k})\frac{d\vec{k}}{dt} = \hbar\vec{v}\dot{\vec{k}} \implies \vec{F} = \hbar\vec{k}$$

wektor pseudopędu spełnia to samo równanie, co pęd dla elektronu poza kryształem (równanie Newtona). \vec{F} może być dowolna, np. $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \rightarrow$ efekt Halla.

 \vec{F} jest siłą zewnętrzną; oddziaływania z rdzeniami atomowymi i innymi elektronami są już uwzględnione w $E(\vec{k})$ i m^*

Przyspieszenie:

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left[\nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \right] = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \dot{\vec{k}} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \vec{F} = (\widehat{m}^*)^{-1} \vec{F}$$

R. Stepniews

<section-header><section-header><section-header><text><equation-block><equation-block><equation-block><equation-block><equation-block><equation-block><equation-block><text>

Dynamika elektronów w krysztale				
Przyspieszenie: $\vec{a} = \vec{v} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left[\nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \right] = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \vec{k} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \vec{F} = (\widehat{m^*})^{-1} \vec{F}$				
tensor dynamicznej masy efektywnej:				
$(\widehat{m^*})^{-1} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar^2} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial k_1^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_1 \partial k_2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_1 \partial k_3} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_2 \partial k_1} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_2^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_2 \partial k_3} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_3 \partial k_1} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_3 \partial k_2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_3^2} \end{bmatrix}$ definicja ta jest dobra dla dowolnego wektora falowego, nie tylko w pobliżu ekstremum!				
Tensor dynamicznej masy efektywnej $\widehat{m^*}$ i pędowej masy efektywnej $\widehat{m_p^*}$: w ogólności $\widehat{m^*} eq \widehat{m_p^*}$.				
Tensor $\widehat{m^*}$ jest symetryczny, dla punktu Γ jest tożsamy z tensorem odwrotności masy efektywnej wprowadzonym przy omawianiu zależności $E(\vec{k})$ w pobliżu ekstremum pasma (Wykład 7)				
w przypadku pasma parabolicznego masy pędowa i dynamiczna są identyczne $\widehat{m^*} = \widehat{m_p^*}$. R. Stępniewski				
2013.06.02				

Przybliżenie masy efektywnej

Przybliżenie masy efektywnej (Effective Mass Approximation – EMA) – J.M. Luttinger, W. Kohn, Physical Review 97, 869 (1955)

w celu wprowadzenia prędkości grupowej tworzyliśmy paczkę falową z otoczenia \vec{k}_{o} , a więc tworzyliśmy kombinację liniową funkcji Blocha, co w przybliżeniu dało iloczyn amplitudy blochowskiej $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ i pewnej funkcji obwiedni ("enwelopy") – tutaj była ona zależna od czasu

$$\psi_n(\vec{r}) = A u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) e^{i\left(\vec{k}_0 \vec{r} - \omega_0 t\right)} \int_{\Delta V_k} e^{i\left(\vec{\xi} \vec{r} - \left(\nabla_{\vec{k}} \omega_{\vec{\xi}}\right) t\right)} d^3 \xi$$

Przybliżenie masy efektywnej podaje przepis jak znaleźć rozwiązanie jednoelektronowego równania Schrödingera z wolnozmiennym na obszarze komórki elementarnej potencjałem $U(\vec{r})$, jeśli znamy rozwiązania $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ równania dla $U(\vec{r}) = 0$ i $\vec{k} = \vec{k}_0$ (oznaczymy je $u_{n\vec{k}_o}(\vec{r})$):

Przybliżenie masy efektywnej (Effective Mass Approximation – EMA) Przybliżenie masy efektywnej podaje przepis jak znaleźć rozwiązanie jednoelektronowego równania Schrödingera z wolnozmiennym na obszarze komórki elementarnej potencjałem $U(\vec{r})$, jeśli znamy rozwiązania $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ równania dla $U(\vec{r}) = 0$ i $\vec{k} = \vec{k}_0$ (oznaczymy je $u_{n,\vec{k}_0}(\vec{r})$): $\int -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}) + U(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r})$ Potencjał periodyczny sieci Potencjał volnozmienny Rozwiazaniem dla *n*-tego pasma są funkcje $\Psi_n(\vec{r}) = \Phi_n(\vec{r}) u_{n,\vec{k}_0}(\vec{r})$, gdzie funkcja enwelopy (obwiedni) $\Phi_n(\vec{r})$ musi spełniać równanie masy efektywnej: $\left[\frac{\hbar^2}{2}\sum_{\alpha,\beta}\left(\frac{1}{m^2}\right)_{\alpha,\beta}\left(-i\frac{\partial}{\partial x_\alpha}\right)\left(-i\frac{\partial}{\partial x_\beta}\right) + U(\vec{r})\right]\Phi_n(\vec{r}) = (E - E_n(0))\Phi_n(\vec{r})$ B. Stepniewski

2013-06-02

Przybliżenie masy efektywnej

Przybliżenie masy efektywnej (Effective Mass Approximation – EMA) Rozwiazaniem dla *n*-tego pasma są funkcje $\Psi_n(\vec{r}) = \Phi_n(\vec{r})u_{n,\vec{k}_0}(\vec{r})$, gdzie funkcja enwelopy (obwiedni) $\Phi_n(\vec{r})$ musi spełniać **równanie masy efektywnej**:

$$\left[\frac{\hbar^2}{2}\sum_{\alpha,\beta}\left(\frac{1}{m^*}\right)_{\alpha,\beta}\left(-i\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}}\right)\left(-i\frac{\partial}{\partial x_{\beta}}\right) + U(\vec{r})\right]\Phi_n(\vec{r}) = [E - E_n(0)]\Phi_n(\vec{r})$$

Np.:

$$E\left(\vec{k}\right) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Daje

$$\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\vec{r}) \bigg] \Phi_n(\vec{r}) = [E - E_n(0)] \Phi_n(\vec{r})$$

R. Stepniewsk

jest to, formalnie rzecz biorąc, równanie Schrödingera dla kwazicząstki o masie równej masie efektywnej m^* poruszającej się w potencjale $U(\vec{r})$. Potencjał periodyczny sieci jest uwzględniony poprzez masę efektywną. Jeśli np. $U(\vec{r})$ jest przyciągającym potencjałem domieszki, to enwelopa będzie funkcją zlokalizowaną (donory, akceptory itp.!)

Własności pasm wypełnionych

Liczenie sumarycznego wkładu całkowicie zapełnionego pasma do danej wielkości fizycznej $f(\vec{k})$ wymaga sumowania lub całkowania po wszystkich $k \in SB$ (SB = strefa Brillouina):

$$\langle f(\vec{k}) \rangle = \sum_{k \in SB} f(\vec{k}) \to \int_{k \in SB} f(\vec{k}) \rho(\vec{k}) dV_k = \rho(\vec{k}) \int_{k \in SB} f(\vec{k}) dV_k$$

Sumaryczny pseudopęd znika (bo SB ma środek inwersji!):

$$\langle \hbar \vec{k} \rangle = \rho(\vec{k}) \int\limits_{k \in SB} \hbar \vec{k} \, dV_k = 0$$

Jeśli $f(\vec{k})$ jest funkcją okresową z okresem sieci Bravais, to całkowanie jej **po obszarze komórki** elementarnej Ω daje wartość stałą:

$$I(\vec{r}') = \int_{\Omega} f(\vec{r} + \vec{r}') \, dV = const$$

pochodne znikają:

$$\nabla' I(\vec{r}') = \int \nabla' f(\vec{r} + \vec{r}') \, dV = \int \nabla f(\vec{r} + \vec{r}') \, dV = 0$$

Podobnie $\nabla'^2 I(\vec{r}') = 0$ (ważne: całka musi być po całym obszarze Ω).

Własności pasm wypełnionych

Elektrony całkowicie zapełnionego pasma nie mogą uzyskać dodatkowego pędu pod działaniem siły zewnętrznej – nie dają wkładu do żadnych własności transportowych:

Dziury

Kwazicząstki - dziury

Dla opisania sumarycznych właściwości tych 2N - 1 elektronów wprowadzamy pojęcie nowej kwazicząstki -dziury. Dziura quasi cząstka z dodatnią masą efektywną, która opisuje własności zbioru elektronów w ciele stałym o masie ujemnej z jednym stanem pustym.

Dziury

Kwazicząstki - dziury

Dla opisania sumarycznych właściwości tych 2N-1 elektronów wprowadzamy pojęcie nowej kwazicząstki -dziury. Dziura quasi cząstka z dodatnią masą efektywną, która opisuje własności zbioru elektronów w ciele stałym o masie ujemnej z jednym stanem pustym.

Jeśli f(k) pewna wielkość fizyczna charakteryzująca elektron o wektorze falowym k to wartość tej wielkości dla dziury:

Dziury

Kwazicząstki - dziury

Ładunek dziury jest dodatni gdyż w polu elektrycznym równanie Newtona daje: $\hbar \vec{k}_d = -\hbar \vec{k}_e = +e\vec{E}$

Energia dziury:

2013-06-02

$$E_{d} = \sum_{i=1}^{2N} E(\vec{k}_{i}) - E(\vec{k}_{e}) = E_{0} - E(\vec{k}_{e})$$

rośnie, kiedy *Ee* (a więc energia brakującego elektronu) maleje Jeśli liczymy energię elektronów od dna pasma przewodnictwa, to (E_0 skaluje "0" energii):

$$E_e = -E_G - \frac{\hbar^2 k^2}{2|m_e^*|} \Rightarrow E_d = E_0 + E_G + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_d^*}$$

Dziura jest fermionem (tak jak elektron, którego brakuje w paśmie)

